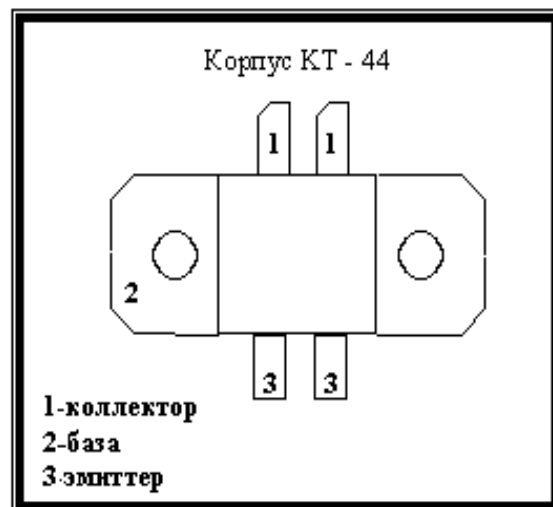


КТ 9136 АС

Мощный СВЧ импульсный транзистор для работы в диапазоне частот 200 - 500 МГц

Диапазон частот	200 - 500 МГц
Выходная мощность	500 Вт
Напряжение питания	45 В
Коэффициент усиления по мощности	7 раз
Класс С	
Схема с общей базой	



Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n СВЧ транзистор КТ9136АС предназначен для построения мощных каскадов передающих устройств и навигационных систем аппаратуры специального назначения. Надежность эксплуатации обеспечивается использованием золотой металлизации,

балластирующих эмиттерных резисторов и 100%-ным контролем по $P_{к\max}$.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ ПРИЕМКЕ И ПОСТАВКЕ

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура среды, °С
		не менее	не более	
Выходная импульсная мощность ($U_{п}=45$ В, $f=500$ МГц, $P_{вх,и}$ не более 71.4 Вт, $\tau_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$), Вт	$P_{вых, и}$	500	-	$t_{к}<40$
Коэффициент усиления по мощности ($U_{п}=45$ В, $f=500$ МГц, $P_{вх,и} = 500$ Вт, $\tau_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$), раз	$K_{ур}$	7	-	$t_{к}<40$
Коэффициент полезного действия коллектора ($U_{п}=45$ В, $f=500$ МГц, $P_{вх,и} = 500$ Вт, $\tau_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$), %	$\eta_{к}$	45	-	$t_{к}<40$
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кэ}=10$ В, $I_{к}=5$ А, $f=100$ МГц)	$ h_{21э} $	3	-	25 ± 10
Обратный ток коллектора ($U_{кб}=60$ В), мА	$I_{кб0}$	-	140	25 ± 10
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{кэк}=45$ В), мА	$I_{кэк}$	-	100	25 ± 10
Обратный ток эмиттера ($U_{эб}=3$ В), мА	$I_{эб0}$	-	100	25 ± 10

Емкость эмиттерного перехода
($U_{кб} = 45 \text{ В}$, $f = 30 \text{ МГц}$), пФ

C_k

-

260

25,10

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНЗИСТОРОВ

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма	Единица измерения	Примечание
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база	$U_{кб \text{ max}}$	60	В	1
Максимально допустимое обратное постоянное напряжение эмиттер-база	$U_{эб \text{ max}}$	4	В	1
Максимально допустимый импульсный ток коллектора	$I_{к, и \text{ max}}$	30	А	2
Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к, и \text{ max}}$	700	Вт	3
Максимально допустимая температура перехода	$t_{п \text{ max}}$	+200	°C	-
Максимально допустимая температура корпуса	$t_{к \text{ max}}$	+125	°C	-
Минимально допустимая температура среды	$t_{с \text{ min}}$	-60	°C	-
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ				
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{т, и п-к}$	0.2	°C/Вт	-

Примечания:

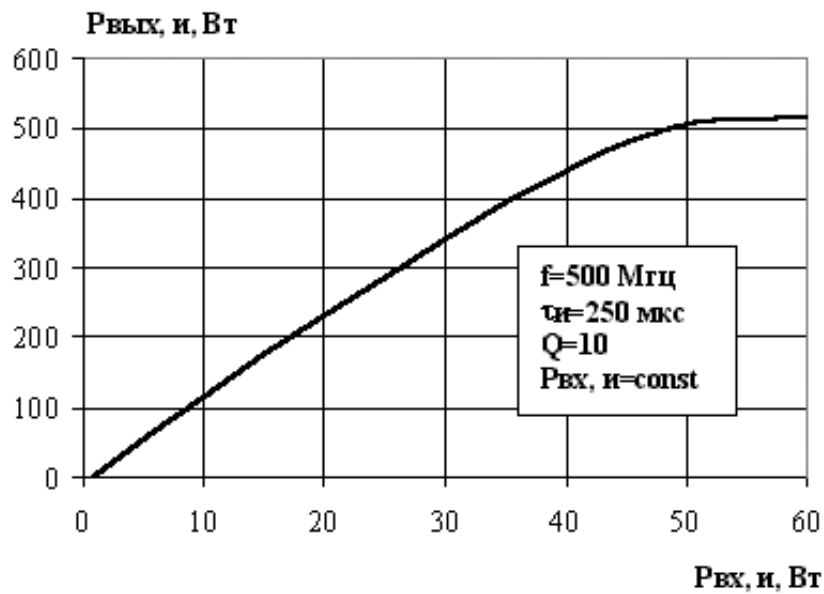
1 - для всего диапазона температур;

2 - для всего диапазона температур, при условии, что $P_{к, и \text{ max}}$ не превышает предельного значения;

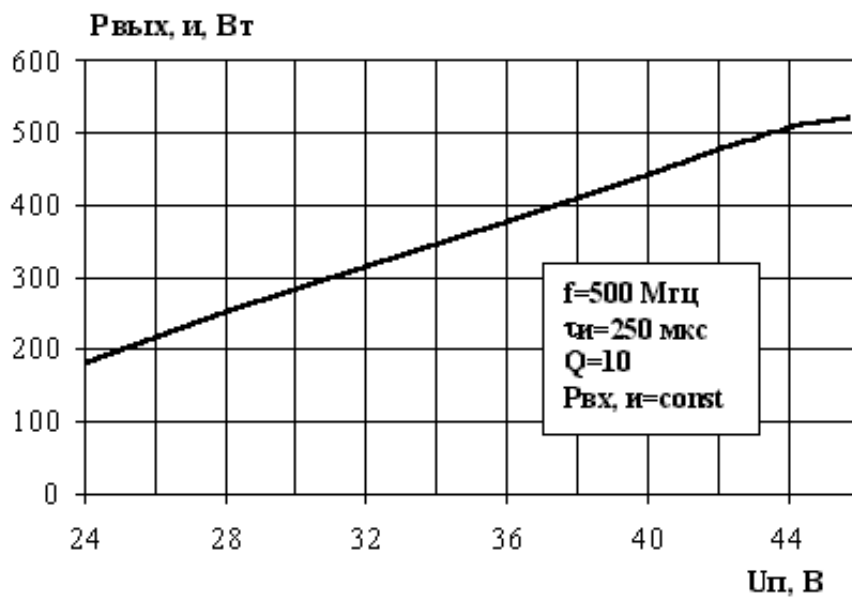
3 - при температуре корпуса от +60°C до +125°C $P_{к, и \text{ max}}$ линейно снижается и рассчитывается по формуле:

$$P_{к, и \text{ max}} = (t_{п \text{ max}} - t_{к}) / R_{т, и п-к}$$

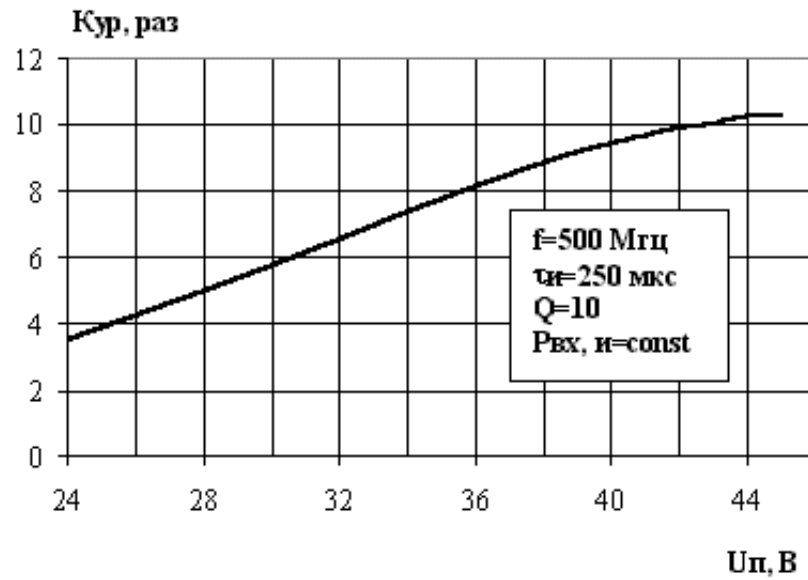
ТИПОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ



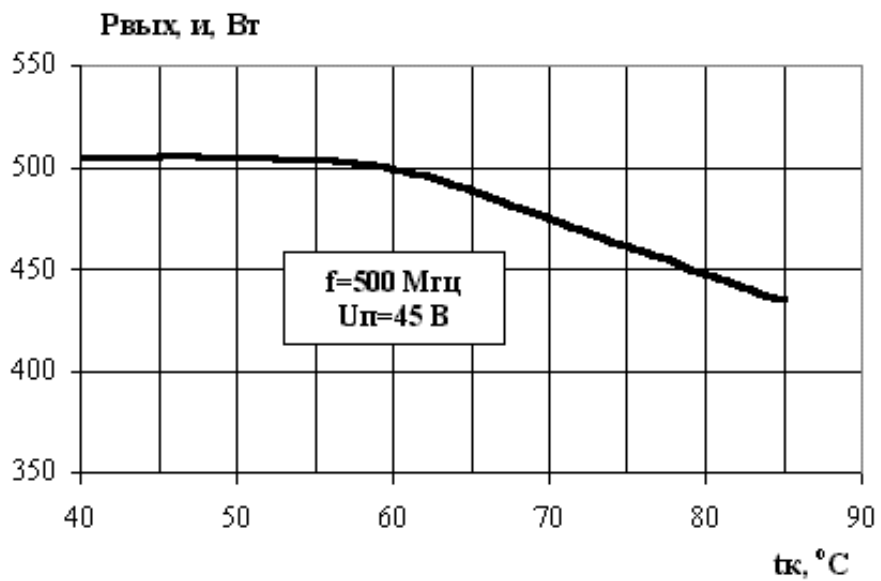
Зависимость выходной импульсной мощности от входной импульсной мощности



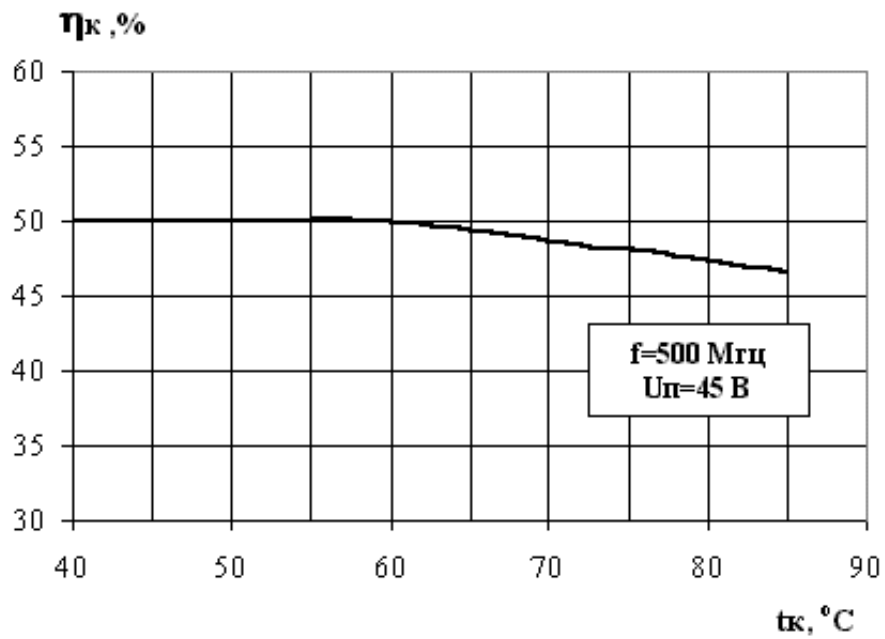
Зависимость выходной импульсной мощности от напряжения питания



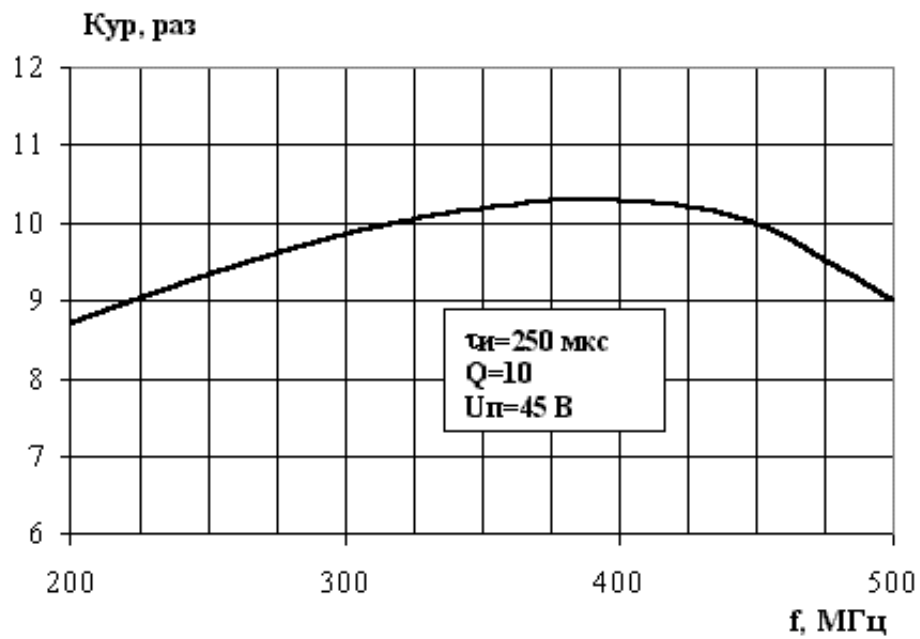
Зависимость коэффициента усиления по мощности от напряжения питания



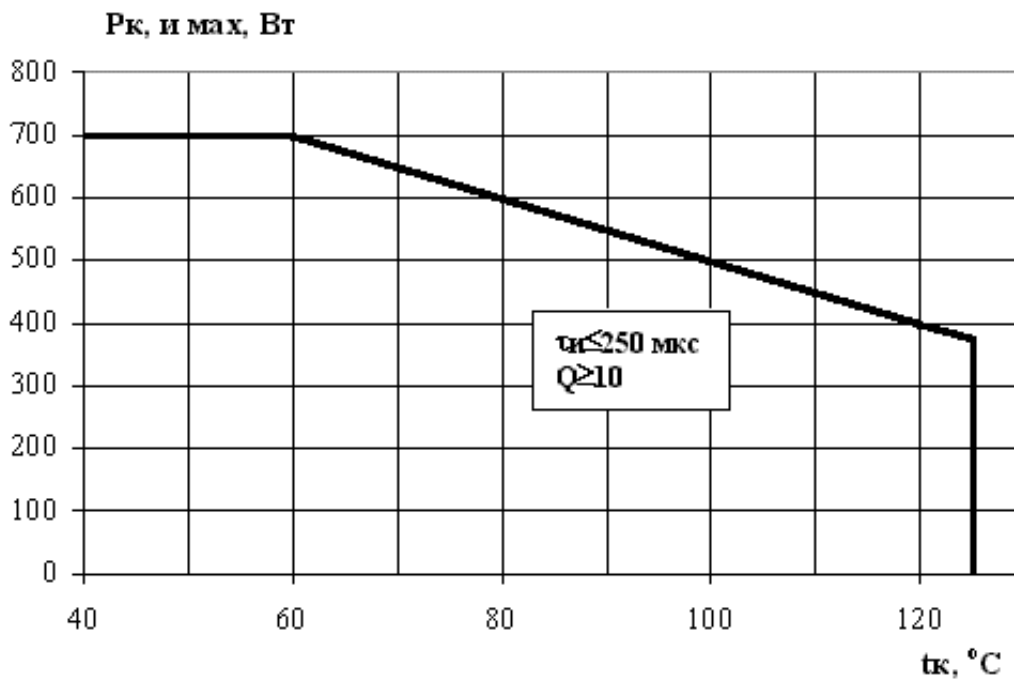
Зависимость выходной импульсной мощности от температуры корпуса



Зависимость коэффициента полезного действия коллектора от температуры корпуса



Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты



Зависимость максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

[Нажмите здесь чтобы связаться с нами прямо сейчас!](#)

[\[Главная страница \]](#)

[\[Мощные СВЧ низковольтные транзисторы \]](#)

[\[Мощные СВЧ импульсные транзисторы \]](#)

[\[Мощные СВЧ линейные транзисторы \]](#)

[\[Модули СВЧ усилители мощности \]](#)

[\[Мощные СВЧ транзисторы \]](#)

[\[Наши реквизиты \]](#)